附表 1：

No.	美國專利號碼	No.	台灣專利對應案
1.	美國專利號 6,039,641	11.	台灣專利申請號 87104256
2.	美國專利號 6,193,770	11.	台灣專利申請號 87104256
3.	美國專利號 6,286,498	12.	台灣專利申請號 87104257
4.	美國專利號 6,679,243	11. 12.	台灣專利申請號 87104256 及 87104257
5.	美國專利號 7,124,753	11. 12.	台灣專利申請號 87104256 及 87104257
6.	美國專利號 7,201,645	13.	台灣專利申請號 94132965
7.	美國專利號 7,285,039		無
8.	美國專利號 7,491,116	14.	台灣專利申請號 94133718
9.	美國專利號 7,544,117		無
10.	美國專利號 8,043,145	14.	台灣專利申請號 94133718

附表 2：

	編號	申請號	專利名稱	專利權人狀態
TW	1	091106560	被覆有無晶鑽石膜的電極	宋健民(2012/7/01公告讓與綠鑽)
TW	2	092104780	無晶鑽石材料的製造方法及其應用	宋健民(2012/8/01公告讓與綠鑽)
TW	3	091103536	含鑽石粉末的散熱體	宋健民(2012/9/11公告讓與綠鑽)
TW	4	092116765	硬銲磨料線鋸及其製法	宋健民(2012/7/01公告讓與綠鑽)
TW	5	095114079	類鑽碳熱電能轉換裝置及其使用和製造方法	宋健民(2012/8/01公告讓與綠鑽)
TW	6	099212797	用以淨化水質的電解裝置	宋健民(2011/10/21公告讓與綠鑽)
TW	7	091103716	披覆鑽石焊料的鑽石或立方氮化硼及其集結體及其製法	宋健民(2012/9/11公告讓與綠鑽)
USA	8	13/111,052	Diamond-Like Carbon Electronic Devices and Methods of Manufacture	宋健民(2012/6/05公告讓與綠鑽)
USA	9	11/809,718	Substrate surface modifications for compositional gradation of crystalline materials and associated products	宋健民(2012/4/03公告讓與綠鑽)
USA	10	12/774089	DIAMOND GAN DEVICES AND ASSOCIATED METHODS	宋健民(2012/6/13公告讓與綠鑽)
USA	11	12/983801	SEMICONDUCTOR-ON-DIAMOND DEVICES AND METHODS OF FORMING	宋健民(2012/4/03公告讓與綠鑽)
USA	12	10/775,042	High pressure crystal growth apparatuses and associated methods	宋健民(2012/2/01公告讓與綠鑽)
USA	13	12/541064	Gem Growth Cubic Press and Associated Methods	宋健民(2012/2/09公告讓與綠鑽)
USA	14	12/174193	Diamond-Like Carbon Electronic Devices and Methods of Manufacture	宋健民(2011/9/19公告讓與綠鑽)
USA	15	12/168110	CMP PAD CONDITIONERS WITH MOSAIC ABRASIVE SEGMENTS AND ASSOCIATED METHODS	宋健民(2011/9/20公告讓與綠鑽)
CN	16	03142946.7	電子元件用散熱件及其製法	宋健民(2012/6/03公告讓與綠鑽)
CN	17	200480022995.6	無晶鑽石材料及其使用和製造方法	宋健民(2012/6/13公告讓與綠鑽)
CN	18	200580023409.4	鑽石底半導體裝置形成方法	宋健民(2012/6/13公告讓與綠鑽)
CN	19	200580024477.2	多晶磨粒及其相關方法	宋健民(2012/6/14公告讓與綠鑽)
CN	20	200480026480.3	超級磨料線鋸及相關製造方法	宋健民(2012/7/03公告讓與綠鑽)
CN	21	03131001.X	含鑽石粉末的散熱體	宋健民(2012/6/13公告讓與綠鑽)
CN	22	201020267636.X	用以淨化水質的電解裝置	宋健民(2011/11/30公告讓與綠鑽)
CN	23	03130999.2	被覆有無晶鑽石膜的電極	宋健民(2010/1/18/公告讓與台鑽科技)
CN	24	03130998.4	披覆焊料的鑽石或立方氮化硼及其集結體及其製法	宋健民(2010/1/18公告讓與台鑽科技)
CN	25	03148262.7	無晶鑽石材料	宋健民(2010/6/01公告讓與台鑽科技)
CN	26	98803985.0	以滲透法硬焊之鑽石研磨工具	宋健民(2009/9/29公告讓與高洋電子)

註：日期以各國專利主管機關之網頁為準

附表 3：

1	TW	094143119	在金屬載體中保有最多超級磨料顆粒的方法	2011/9/6	
2	TW	097112737	化學機械研磨墊修整器及其相關方法	2011/1/3	
3	CN	200610137988.1	高壓結晶成長裝置及其相關方法	2010/5/24	
4	CN	200580014053.8	可控制晶種位置的超級磨粒的合成體	2011/3/1	
5	CN	200780039237.9	發光二極管裝置及其相關方法	2012/3/20	
6	CN	200680003002.X	超硬切割裝置及其製造方法	2012/3/29	
7	CN	200780046335.5	化學機械拋光墊調整器及其相關方法	2011/12/6	未獲權即放棄
8	CN	200680003538.1	類鑽碳熱電能轉換裝置及其使用和製造方法	2009/12/7	
9	CN	200680052157.2	電鍍研磨工具及方法和模具	2010/10/21	
10	CN	200810174978.4	類鑽碳電子裝置及其製造方法	2011/1/25	
11	CN	200910169357.1	寶石級生長的六面頂壓機及其相關方法	2011/3/22	
12	CN	200910258915.1	鑽石顆粒合成方法及其鑽石	2011/10/11	
13	HK	07107676.9	高壓結晶成長裝置及其相關方法	2010/3/8	
14	KR	10-1999-7009094	以滲透法硬焊之鑽石研磨工具 Brazed diamond tools by infiltration	2009/11/3	
15	KR	10-1999-7009095	具規則性排列之磨料顆粒的研磨工具及其製造方法 Abrasive tools with patterned grit distribution and method	2008/11/4	就已獲准之專利放棄繳納年費
16	TW	087111378	製造超硬研磨工具之低溫壓入法	2008/5/21	
17	TW	087104257	具規則性排列之磨料顆粒的研磨工具及其製造方法	2012/3/20	就已獲准之專利放棄繳納年費；91年JV合約明訂四個專利之一
18	TW	091103537	以鑽石微粉製成的拋光片及其製法	2007/12/11	
19	TW	088100751	含有氮化碳矽之材料及其製法與用途	2010/4/1	就已獲准之專利放棄繳納年費
20	TW	088107211	鑽石微粉的製造方法	2006/2/16	
21	TW	095115836	超硬切割裝置及其製造方法	2011/9/29	
22	TW	095133055	於有機材料中結合超級磨粒的方法	2012/7/19	就已獲准之專利放棄繳納年費；MOU3 附件四ODD專利之一
23	TW	094147166	化學機械研磨修整器	2012/7/19	
24	TW	095147436	形成元件之模具總成及其形成方法	2010/12/28	
25	TW	094100841	高壓晶體生長裝置以及其方法	2011/7/26	
26	CN	031309976	滑行鞋	2008/2/28	
27	CN	200680009712.3	電致發光裝置以及使用該電致發光的電發光方法	2010/11/11	
28	CN	98803945.1	具規則性排列之磨料顆粒的研磨工具及其製造方法	2012/1/31	
29	CN	200580034721.3	具有定向顆粒的化學機械拋光墊修整器其相關方法	2012/7/19	就已獲准之專利放棄繳納年費
30	CN	200580040984.5	非平面的化學機械拋光墊修整器及其相關方法	2012/7/19	
31	CN	201020267639.3	沙漏裝置	2012/5/16	
32	CN	200580007650.8	高壓結晶成長裝置及其相關方法	2011/11/15	
33	JP	10-542815	以滲透法硬焊之鑽石研磨工具	2009/04/09	
34	US	11497797	Carbon nanotube devices and uses therefor	無	
35	US	10791300	High pressure superabrasive particle synthesis	無	